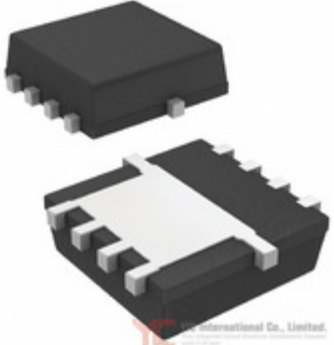

	<h2 style="color: #D9534F;">SIS410DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIS410DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 35A PPAK 1212-8
	Datenblätter:  SIS410DN-T1-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 17996 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIS410DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 35A PPAK 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	17996 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.8 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SIS410DN-T1-GE3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 35A (Tc) 3.8W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SIS410DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS410DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS410DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS410DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS412DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS407DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 25A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS410DN VB SIS410DN VB</p>	 <p>SIS407DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 25A 1212-8 PPAK</p>
 <p>SIS407DN VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p>SIS412DN-T1-E3 VISHAY SIS412DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIS412DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS412DN V SIS412DN V</p>

SIS410DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS410DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS410DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS410DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS410DN-T1-GE3
SIS410DN-T1-GE3 Electronic	SIS410DN-T1-GE3 Komponenten	SIS410DN-T1-GE3-Verteiler	SIS410DN-T1-GE3-Bild	SIS410DN-T1-GE3 Teil	SIS410DN-T1-GE3 Teil
SIS410DN-T1-GE3 Preis	SIS410DN-T1-GE3 Hersteller	SIS410DN-T1-GE3 Bild	SIS410DN-T1-GE3 Aktie	SIS410DN-T1-GE3 Inventar	SIS410DN-T1-GE3 Inventar
SIS410DN-T1-GE3 Neu	SIS410DN-T1-GE3 Original	SIS410DN-T1-GE3 garantiert	SIS410DN-T1-GE3 RFQ	SIS410DN-T1-GE3 Online bestellen	SIS410DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited